性能特点：

- 频率范围：：8.0GHz～12.0GHz
- 增益：27dB（正斜率）
- 噪声系数：1.3dB
- P1dB：2dBm
- 直流供电：+3.3V@12mA ;+5V@12mA
- 芯片尺寸：2.70mm×1.30mm×0.07mm

产品简介：

NC10149C-812 和 NC10149C-812M 是两种 GaAs MMIC 低噪声放大器芯片，其频率范围覆盖 8GHz～12GHz，增益大于 26dB。该芯片采用+3.3V/+5V 单电源供电。

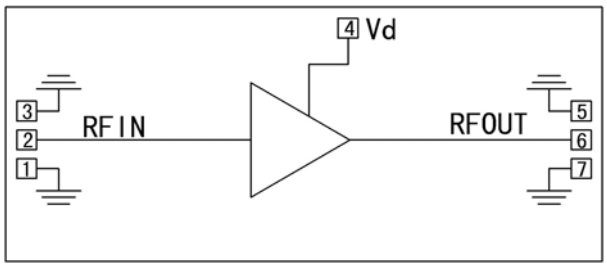
电参数（TA=+25℃，Vd=+5V）

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	8-12			GHz
增益	26	27		dB
增益平坦度		±0.8		dB
噪声系数		1.3		dB
P1dB		2		dBm
输入驻波		1.5		-
输出驻波		1.3		-
静态电流		12		mA

使用限制参数

最大漏偏压	+6V
最高输入功率	+18dBm
储存温度	-65℃～+150℃
使用温度	-55℃～+125℃

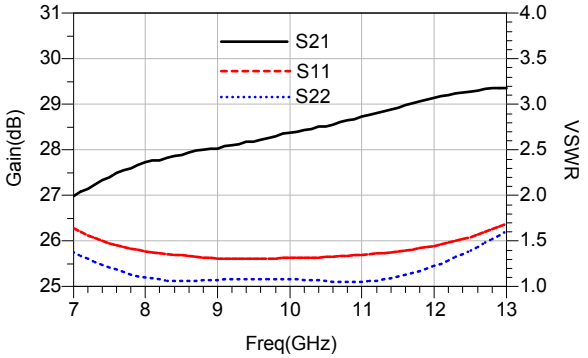
功能框图



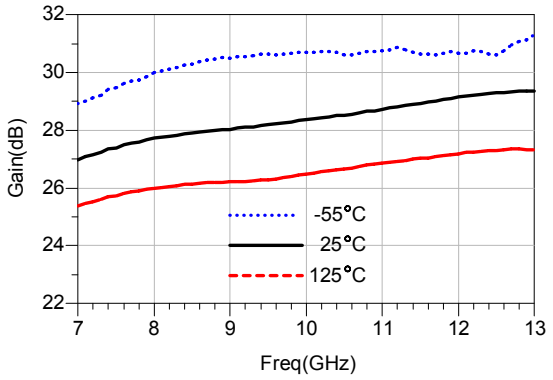
典型曲线

为了使用户更直观的了解该芯片的性能指标，下面给出了各个指标的曲线图。

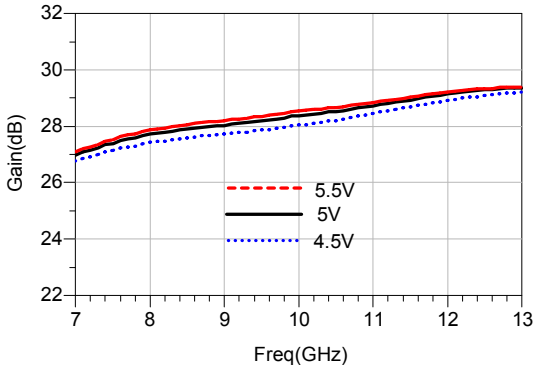
增益和输入输出驻波



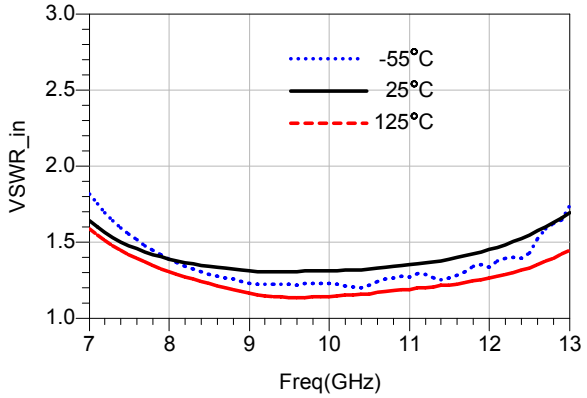
增益 vs.温度



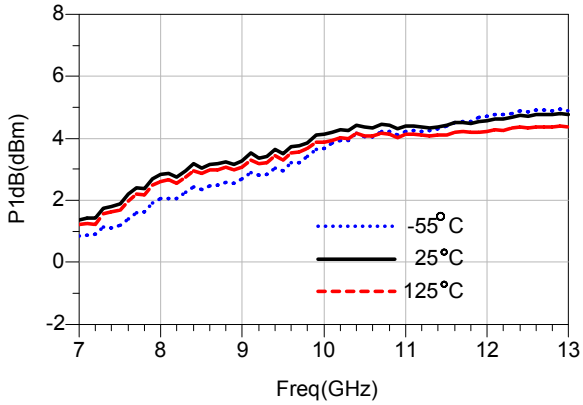
增益 vs.电压



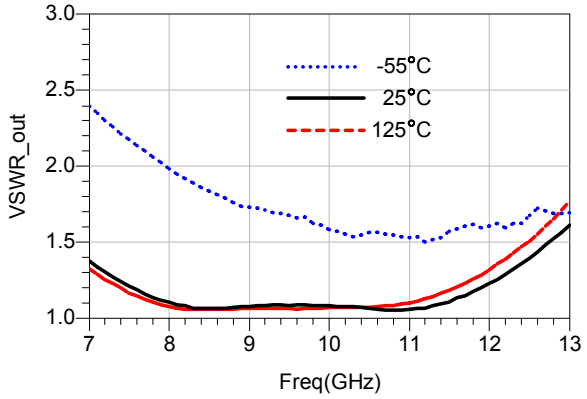
输入驻波 vs.温度



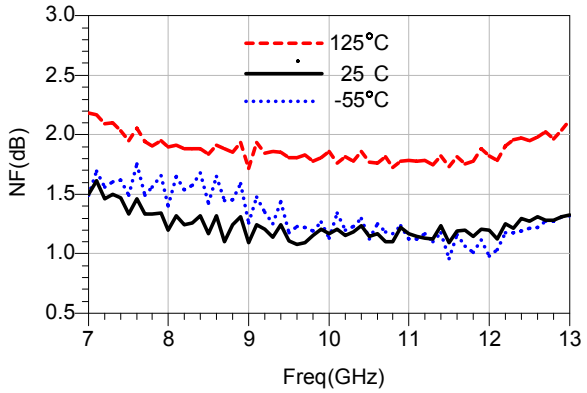
P1dB vs.温度



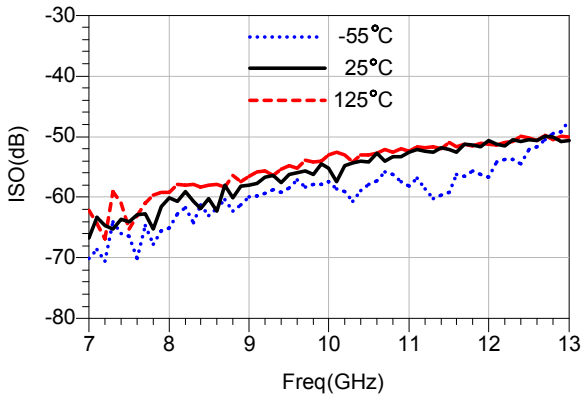
输出驻波 vs.温度



噪声系数 vs.温度



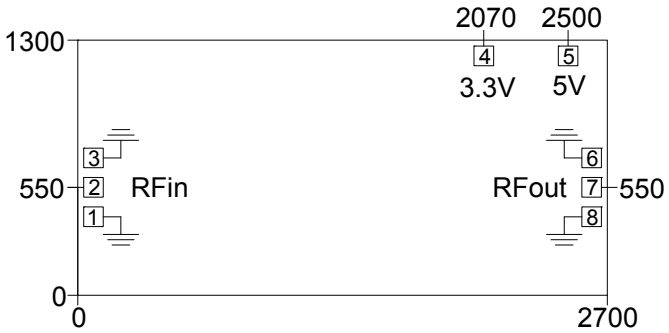
反向隔离 vs.温度



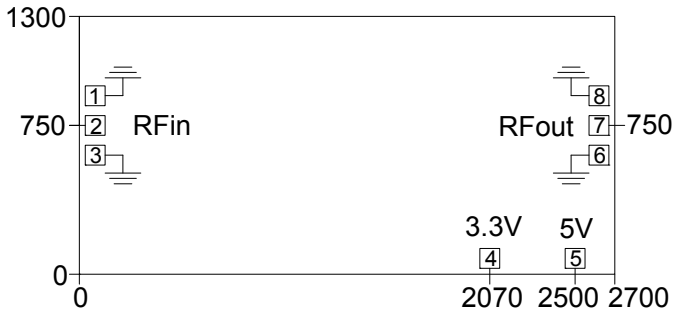
外形尺寸

NC10149C-812(M) 的外形尺寸图

NC10149C-812



NC10149C-812M



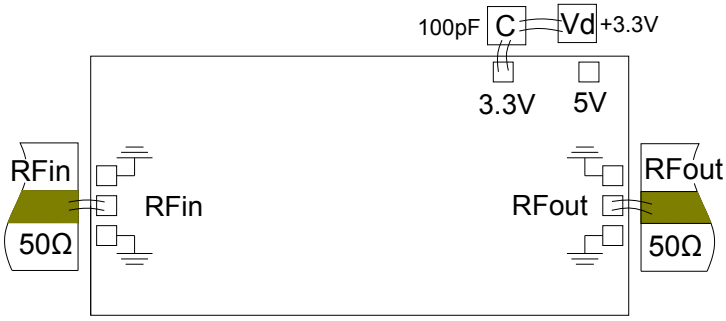
注：所有尺寸单位为微米（μm）；RF 压点尺寸 90×90μm^2；
DC 压点尺寸 100×100μm^2 ；芯片厚度 100μm；
外形长宽尺寸公差：±100μm。

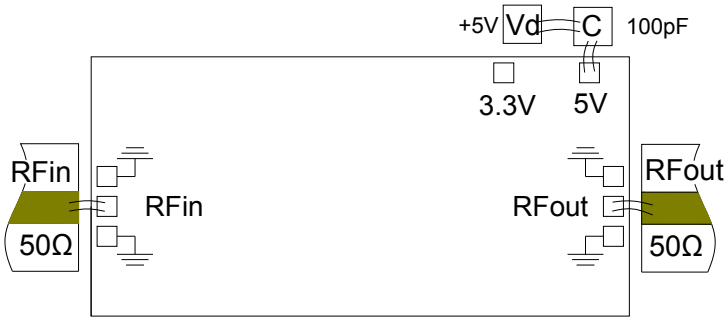
键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
2	RFin	射频信号输入端，外接 50 欧姆系统，无需隔直电容
4	Vd1	放大器工作电压馈电端，需外置 100pF 电源滤波电容
5	Vd2	放大器工作电压馈电端，需外置 100pF 电源滤波电容
7	RFout	射频信号输出端，外接 50 欧姆系统，无需隔直电容
1，3，6，8	GND	管壳底部需大面积接地，保证良好散热

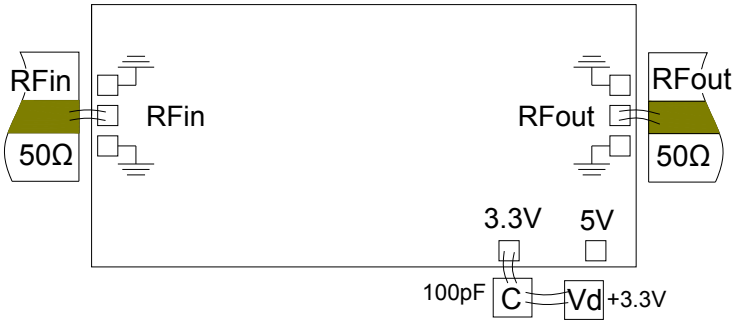
建议装配图

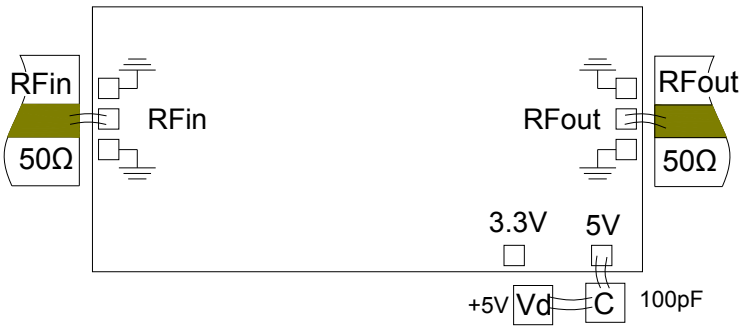
NC10149C-812





NC10149C-812M





注意事项：

1) 在净化环境装配使用。
2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心。
3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25μm 金丝），键合线尽量短，不要长于 450μm。
4) 输入输出有隔直电容。
5) 用 80/20 金锡焊料烧结，烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒。
6) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。
7) 干燥、氮气环境储存。
8) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。
9) 有问题请与供货商联系。